

# US7500

US7500は、NPN型シリコン・フォトランジスタチップをセラミックシステムに組み込んだシリコンフォトランジスタです。

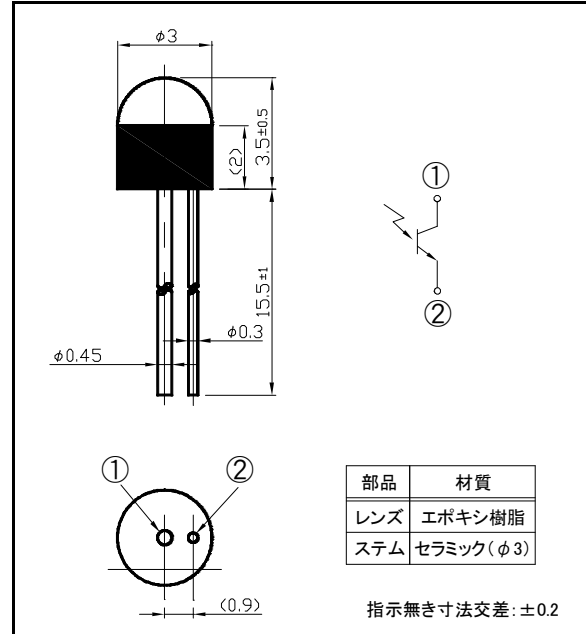
■ 特長

- ・高感度フォトランジスタ
- ・放熱性の高いφ3セラミックシステムで高信頼度
- ・RoHS適合品

■ 用途

- ・センサ用受光素子

■外形寸法(単位:mm)



■ 絶対最大定格(Ta=25°C)

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	20	V
エミッタ・コレクタ間電圧	$V_{ECO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	20	mA
コレクタ損失	$P_C$	75	mW
動作温度	$T_{opr}$	-30~+85	°C
保存温度	$T_{Stg}$	-40~+100	°C
半田付温度 ※1	$T_{sol}$	260	°C

※1 セラミックパッケージ底面から2mm以上の位置で5秒以内

■ 電氣的・光学的特性(Ta=25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
光電流 ※2	$I_C$	$V_{CE}=3V, E_V=500lux$	1.0	2.8	-	mA
暗電流 ※2	$I_{CEO}$	$V_{CE}=12V, E_V=0lux$	-	-	0.2	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 ※2	$V_{CEO(sat)}$	$I_C=2mA, E_V=1000lux$	-	0.25	0.5	V
ピーク感度波長	$\lambda_p$		-	910	-	nm
指向角半値幅	$\Delta\theta$		-	±60	-	deg
応答時間	上昇	$V_{CE}=5V, I_C=2mA$ $R_L=100\Omega$	-	7.5	-	μsec
	下降		-	7.7	-	

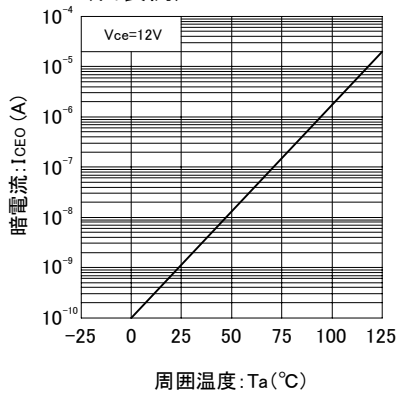
※2  $E_V$ =CIE標準A光源

# US7500

## 定格・特性曲線

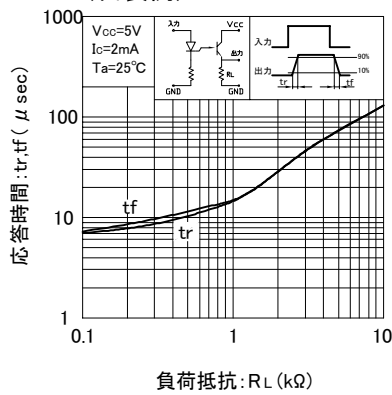
### 暗電流-周囲温度特性

(代表例)



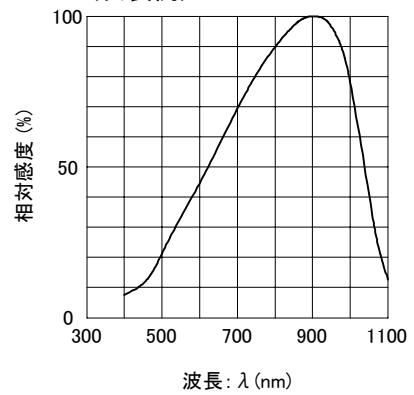
### 応答時間-負荷抵抗特性

(代表例)



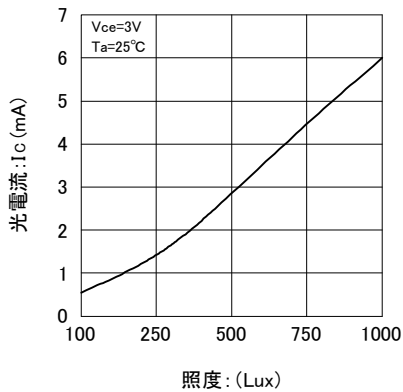
### 分光感度特性

(代表例)

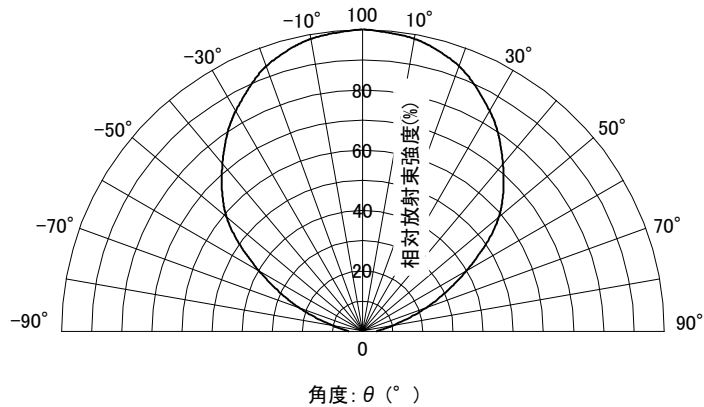


### 光電流-照度特性

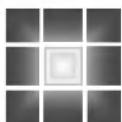
(代表例)



### 指向角特性(代表例)



- このカタログに記載している仕様、特性、データ等は改良等のために予告なしに変更することがあります。
- ご使用の際には最新の仕様書によりご確認をお願い致します。



Uni-Technology

株式会社 ユニテク

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台9-23-11  
TEL: 045-832-5921 FAX: 045-832-5922